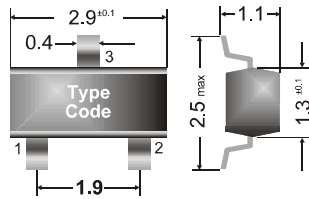


NPN

Surface mount Si-Epitaxial Planar Transistors
Si-Epitaxial Planar Transistoren für die Oberflächenmontage

NPN



Dimensions / Maße in mm
 1 = B 2 = E 3 = C

Power dissipation – Verlustleistung 250 mW

Plastic case SOT-23
 Kunststoffgehäuse (TO-236)

Weight approx. – Gewicht ca. 0.01 g

Plastic material has UL classification 94V-0
 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped and reeled
 Standard Lieferform gegurtet auf Rolle

Maximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**

			BF 820	BF 822
Collector-Emitter-voltage	B open	V_{CE0}	300 V	250 V
Collector-Base-voltage	E open	V_{CB0}	300 V	250 V
Emitter-Base-voltage	C open	V_{EB0}	5 V	
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	250 mW ¹⁾	
Collector current – Kollektorstrom (dc)		I_C	50 mA	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		I_{CM}	100 mA	
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		I_{BM}	50 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	- 65...+ 150°C	

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**

		Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom				
$I_E = 0, V_{CB} = 200\text{ V}$	I_{CB0}	–	–	10 nA
$I_E = 0, V_{CB} = 200\text{ V}, T_j = 150^\circ\text{C}$	I_{CB0}	–	–	10 μA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom				
$I_C = 0, V_{EB} = 5\text{ V}$	I_{EB0}	–	–	50 nA
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungsspg. ²⁾				
$I_C = 30\text{ mA}, I_B = 5\text{ mA}$	V_{CEsat}	–	–	600 mV

¹⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß

²⁾ Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾ $V_{CE} = 20\text{ V}, I_C = 25\text{ mA}$ h_{FE}	50	–	–
Gain-Bandwidth Product – Transistfrequenz $V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$ f_T	60 MHz	–	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität $V_{CB} = 30\text{ V}, I_E = i_e = 0, f = 1\text{ MHz}$ C_{CB0}	–	1.6 pF	–
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R_{thA} 420 K/W ²⁾		
Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren	BF 821, BF 823		

Marking - Stempelung

BF 820 = 1V

BF 822 = 1X

¹⁾ Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

²⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß